

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 11月5日(木) 10:00~15:20

6日(金) 11:00~15:20

会場 機械振興会館6階67号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線: 神谷町駅下車徒歩8分. <http://www.jspmi.or.jp/about/access.html>)

議題 プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

5日午前

1. [招待講演] 半導体における不純物拡散モデリングの現状 植松真司(慶大)
2. バルク CMOS におけるシングルイベントラッチアップに対する Deep P-well の効果
○加藤貴志・松山英也(SNI)
3. モンテカルロ法による超高速イメージセンサの解析
○南谷夏海(阪大)・Vu Truon Son Dao・下ノ村和弘・江藤剛治(立命館大)・鎌倉良成・森 伸也(阪大)

5日午後(13:30~)

4. [招待講演] SISPAD 2015 レビュー 三成英樹(ソニー)
5. [招待講演] SISPAD2015 レビュー 国清辰也(ルネサスエレクトロニクス)

6日午前

1. [招待講演] 歪みグラフェンを用いたディラック電子エンジニアリング素子のシミュレーション
○相馬聡文・田中未来・市原圭祐・迫田翔太郎・笹岡健二・小川真人(神戸大)

6日午後(13:30~)

2. [招待講演] Si 基板上 GaN パワーデバイスと電力変換機器への応用
○石田秀俊・石田昌宏・上田哲三(パナソニック)
3. [招待講演] 界面準位が 4H-SiC MOSFET のスイッチング動作に与える影響について
○酒井 敦・永久克己・園田賢一郎(ルネサスエレクトロニクス)・久田賢一・新井耕一・山本陽一(ルネサス)・谷沢元昭・山口泰男(ルネサスエレクトロニクス)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月14日(月) 龍谷大響都ホール校友会館〔締切済〕テーマ:シリコン関連材料の作製と評価及びディスプレイ技術

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp